

EC1001P超薄型1005/0402尺寸220nF硅电容器

产简介

特性

- 220nF电容
- AC / DC偏置变化极低
- 占用空间1.00mm x 0.50mm (0402)
- 超薄型150μm
- ESL (等效串联电感) 和ESR (等效串联电阻) 极低
- 工作温度范围内稳定性高
- 低漏电流
- 无铅铜表面处理, 兼容自动或手动回流焊。可根据要求提供其他端接。
- 工作温度范围: -55°C至+125°C

应用

- 配电网的去耦电容
- 稳压器 (VR) 的旁路电容
- 抑制电源噪声
- 保障高速IC的电源完整性
- 保障高速接口的信号完整性
- 抑制高频噪声
- 其他要求超薄型的应用场合

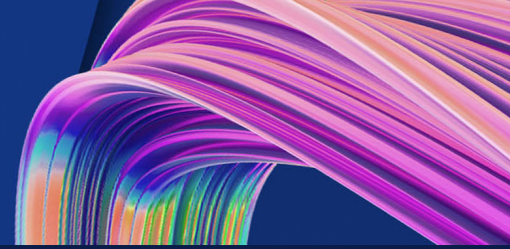
简述

EC1001P ECAP是一款220nF的高性能、超薄型硅电容器, 用于保障高di / dt SoC和高速通信SoC的电源完整性和信号完整性。该电容阵列具有极低的ESL (等效串联电感) 和ESR (等效串联电阻), 高频性能出色, 适合用作电源的去耦电容和高速数字SoC的旁路电容。

EC1001P的厚度极低 (150 μm, 不包括焊盘), 可用于严格限高条件的高级组装 (处理器封装、BGA侧面封装、嵌入式封装等)。

安普沃尔的硅电容器产品行业领先, 工作电压和温度范围内的稳定性极高。因此, ECA P电容不会像MLCC一样降额运行。单个220nF ECAP的有效电容与400nF X5R MLCC相当。

ance Information - Empower Semiconductor Confidential



EC1001P超薄型1005/0402尺寸220nF硅电容器

资料信息声明和法律免责声明

预告信息（工程原型，可提供少量样品）或初步信息（预生产或首次生产）旨在向客户提供产品线的补充信息，这些产品仍然处于“预生产”状态。预告性能数据可一定程度上反映“量产”状态的性能数据，但以上信息细节如有更改，恕不另行通知。请与您当地的销售处联系，获取产品当前状态和最新规格的详细信息。

安普沃尔半导体科技有限公司
1164 Cadillac Ct.
Milpitas, CA 95035

版权所有 © 2021 安普沃尔半导体科技有限公司

安普沃尔产品仅通过简述出售。安普沃尔半导体科技有限公司保留随时更改电路设计、软件和/或规格的权利，恕不另行通知。请注意，下单前务必核实数据手册是否为最新版本。安普沃尔尽力提供准确和可靠的信息。但是，安普沃尔或其子公司，对使用该信息的行为不承担任何责任；对使用该信息而导致的任何专利侵权或对第三方的侵权不承担任何责任。安普沃尔或其子公司的任何专利或相关权利，均不以暗示或其他方式授予任何许可。

欲知更多安普沃尔半导体科技有限公司及其产品的信息，请访问www.empowersemi.com。

Empower Semiconductor Confidential